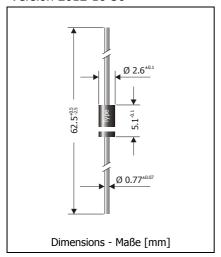


## 1N4001 ... 1N4007, 1N4007-13, EM513, EM516, EM518

## Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden

## Version 2012-10-30



Nominal current Nennstrom	1 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	502000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	DO-41 DO-204AL
Weight approx. Gewicht ca.	0.4 g

Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack



Maximum ratings Grenzwerte

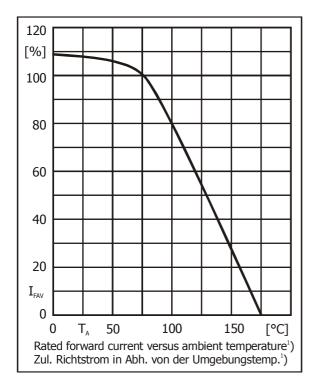
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{\text{RRM}}\left[V\right]$	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{\mbox{\scriptsize RSM}}$ [V]
1N4001	50	50
1N4002	100	100
1N4003	200	200
1N4004	400	400
1N4005	600	600
1N4006	800	800
1N4007	1000	1000
1N4007-13	1300	1300
EM513	1600	1600
EM516	1800	1800
EM518	2000	2000

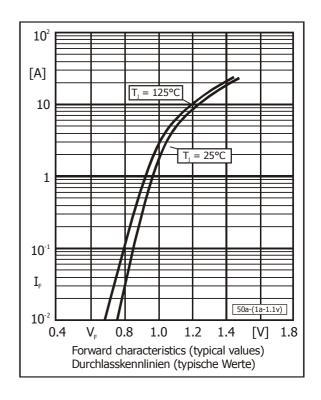
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_A = 75$ °C $T_A = 100$ °C	$\mathbf{I}_{FAV}$	$^{1}$ A $^{\scriptscriptstyle 1}$ ) $^{0.8}$ A $^{\scriptscriptstyle 1}$ )
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	$I_{FRM}$	10 A ¹)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^{\circ}C$	$I_{\text{FSM}}$	50/55 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25$ °C	i²t	12.5 $A^2$ s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$\begin{matrix} T_j \\ T_S \end{matrix}$	-50+175°C -50+175°C

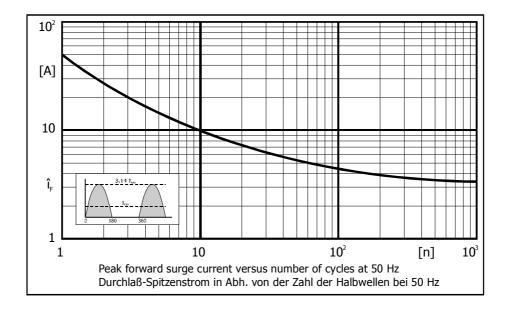
<sup>1</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case



Characteristics				Kennwerte
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25$ °C	$I_F = 1 A$	$V_{F}$	< 1.1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25$ °C $T_j = 100$ °C	$egin{aligned} V_R &= V_{RRM} \ V_R &= V_{RRM} \end{aligned}$	$egin{array}{c} \mathbf{I}_{R} \ \mathbf{I}_{R} \end{array}$	< 5 μA < 50 μA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	:		$R_{\text{thA}}$	< 45 K/W <sup>1</sup> )
Thermal resistance junction to leads Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht			$R_{\text{thL}}$	< 15 K/W







Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden